

# KT868A, KT868B

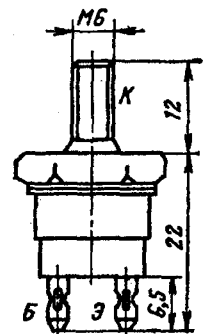
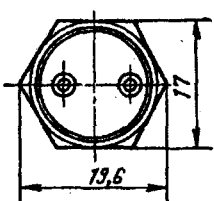
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-p-n высоковольтные переключаемые. Предназначены для применения в ключевых схемах источников питания телевизионных приемников и других переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе, тип корпуса КТ-9. Масса транзистора не более 20 г.

## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{кз} = 5 \text{ В}$ ,  $I_k = 0,6 \text{ А}$  при  $T_k = +25^\circ\text{С}$ :

KT868A ..... 10...60



KT868B, не менее	10
при $T_k = +100^\circ\text{С}$ :	
KT868A	7...60
KT868B, не менее	7
при $T_k = -45^\circ\text{С}$ :	
KT868A	5...60
KT868B, не менее	5
Модуль коэффициента передачи тока	
при $U_{кз} = 10 \text{ В}$ , $I_k = 0,2 \text{ А}$ ,	
$f = 1 \text{ МГц}$ , $T_k = +25^\circ\text{С}$ , не менее	8
Граничное напряжение при $I_k = 0,1 \text{ А}$ , не менее:	
при $T_k = +25^\circ\text{С}$ :	
KT868A	400 В
KT868B	375 В
при $T_k = +100^\circ\text{С}$ и $T_k = -45^\circ\text{С}$ :	
KT868A	350 В
KT868B	300 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, не более:

при  $I_k = 2,5 \text{ А}$ ,  $I_6 = 0,5 \text{ А}$  ..... 1,5 В

при  $I_k = 4 \text{ А}$ ,  $I_6 = 1,25 \text{ А}$  ..... 3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_k = 4 \text{ А}$ ,  
 $I_6 = 1,25 \text{ А}$ , не более ..... 1,6 В

Время рассасывания при  $U_{кз} = 200 \text{ В}$ ,  $I_k = 2,5 \text{ А}$ ,  
 $I_6 = 0,5$  ..... 0,6...3,5 мкс

Время спада при  $U_{кз} = 200 \text{ В}$ ,  $I_k = 2,5 \text{ А}$ ,  
 $I_6 = 0,5 \text{ А}$  ..... 0,05...0,6 мкс

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кз} = 80 \text{ В}$ ,  
 $f = 0,3 \text{ МГц}$  ..... 40...100 пФ

Обратный ток коллектора, не более:

при  $T_k = +25^\circ\text{С}$ :

KT868A при  $U_{кз} = 900 \text{ В}$  ..... 3 мА

KT868B при  $U_{кз} = 750 \text{ В}$  ..... 3 мА

при  $T_k = +100^\circ\text{С}$  и  $T_k = -45^\circ\text{С}$ :

KT868A при  $U_{кз} = 900 \text{ В}$  ..... 5 мА

KT868B при  $U_{кз} = 750 \text{ В}$  ..... 5 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{эб} = 5 \text{ В}$  и

$T_k = +25^\circ\text{С}$ , не более ..... 20 мА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при  $T_k = -45^\circ\text{С}...+100^\circ\text{С}$ :

KT868A ..... 900 В

KT868B ..... 750 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{об} = 100 \text{ Ом}$ :

KT868A ..... 400 В

KT868B ..... 375 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при  $U_{эб} = 0 \text{ В}$ ,

$t_n < 80 \text{ мкс}$ ,  $t_f > 1 \text{ мкс}$ ,  $Q > 2$ ,  $T_k = -20^\circ\text{С}...+100^\circ\text{С}$ :

KT868A ..... 900 В

KT868B ..... 800 В

Постоянное напряжение эмиттер-база ..... 5 В

Постоянный ток коллектора ..... 6 А

Импульсный ток коллектора ..... 8 А

Постоянный ток базы ..... 3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup> ..... 70 Вт

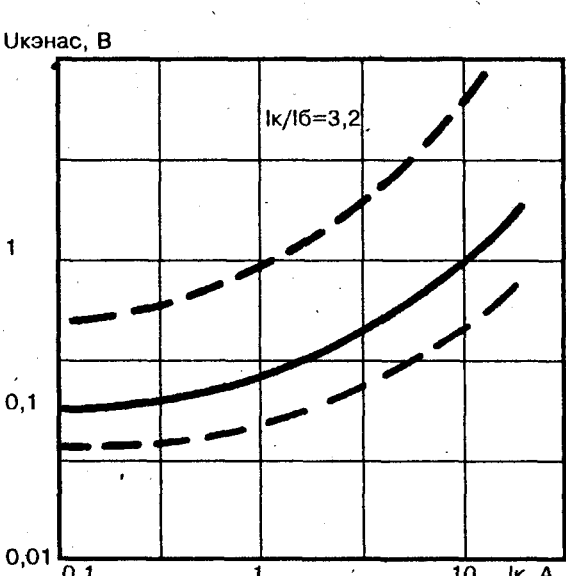
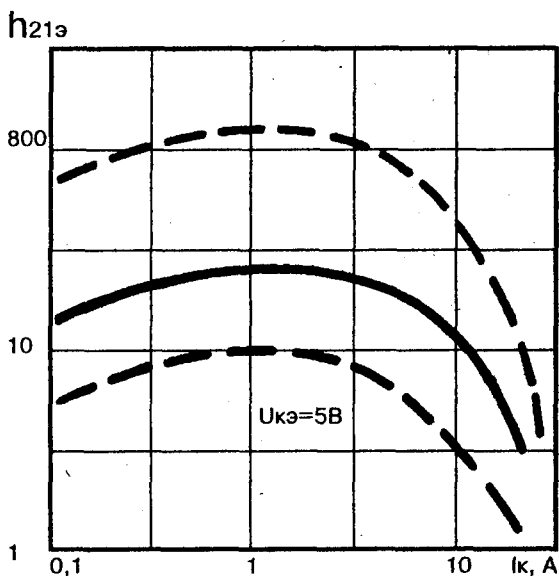
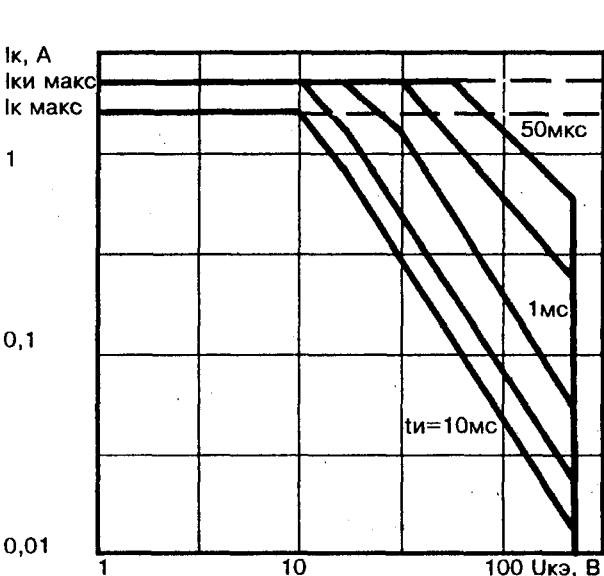
Температура p-n перехода ..... +150°C

Температура окружающей среды ..... -45°C...T<sub>k</sub> = +100°C

<sup>1</sup> При  $T_k = +50...+100^\circ\text{С}$  постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется

из выражения

$$P_{к, \text{макс}} = (150 - T_k) / 0,7, \text{ Вт}$$



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора